

## PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 11-233402

(43)Date of publication of application : 27.08.1999

(51)Int.Cl.

H01L 21/027  
B08B 7/00

(21)Application number : 10-027301

(71)Applicant : NIKON CORP

(22)Date of filing : 09.02.1998

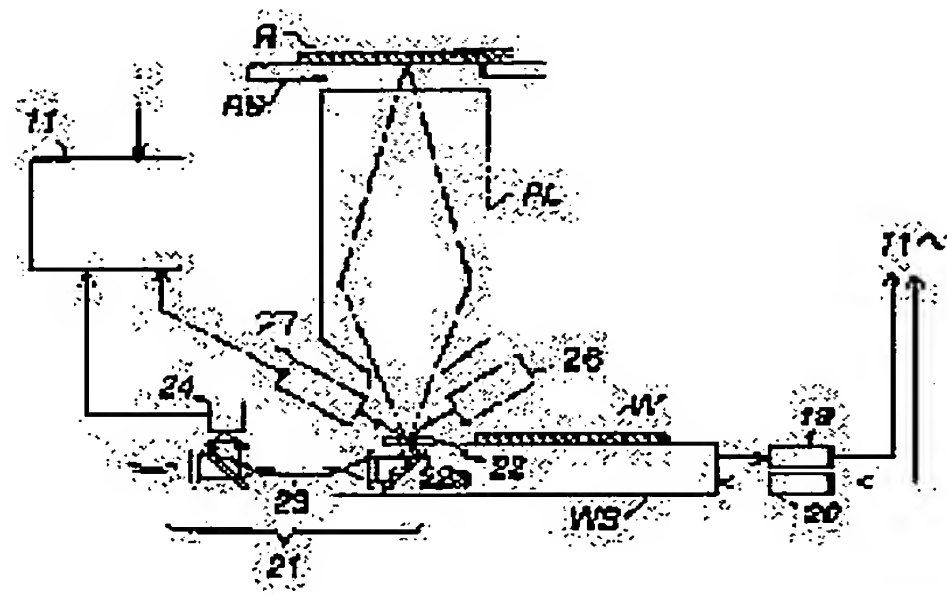
(72)Inventor : MATSUMOTO YUKAKO

## (54) OPTICAL CLEANING METHOD FOR OPTICAL ELEMENT AND PROJECTION ALIGNER

## (57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To enable sufficient optical cleaning or a photosensitive surface of an optical element substrate, by causing a cleaning light to be incident from a direction opposite to the proceeding direction of an exposure light.

SOLUTION: A projection optical system PL is optically cleaned by a pulse light cast thereon from a backward light emitting system 21. In this case, since the pulse light proceeds from the side of a wafer stage WS in a direction opposite to an exposure light, the pulse light is cast on a surface opposite to the surface optically cleaned by the exposure light. Therefore, a contaminant attached on the surface of projection optical system PL on the wafer side which cannot be perfectly removed by the exposure light from the reticle side can be removed. By scanning the wafer stage WS by cleaning light also from the backward light emitting system 21 in parallel with bank pulses before exposure, optical cleaning can be carried out also with the light from the backward light emitting system 21 cast on the surface of the projection optical system PL on the wafer stage side. Therefore, the optical cleaning time can be reduced.



## LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.02.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's  
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-233402

(43)公開日 平成11年(1999) 8月27日

(51)Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

F I

H 0 1 L 21/027

H 0 1 L 21/30

5 0 3 Z

B 0 8 B 7/00

B 0 8 B 7/00

H 0 1 L 21/30

5 0 3 G

審査請求 未請求 請求項の数10 O L (全 9 頁)

(21)出願番号 特願平10-27301

(22)出願日 平成10年(1998) 2月9日

(71)出願人 000004112

株式会社ニコン

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号

(72)発明者 松本 由佳子

東京都千代田区丸の内3丁目2番3号 株  
式会社ニコン内

(74)代理人 弁理士 永井 冬紀

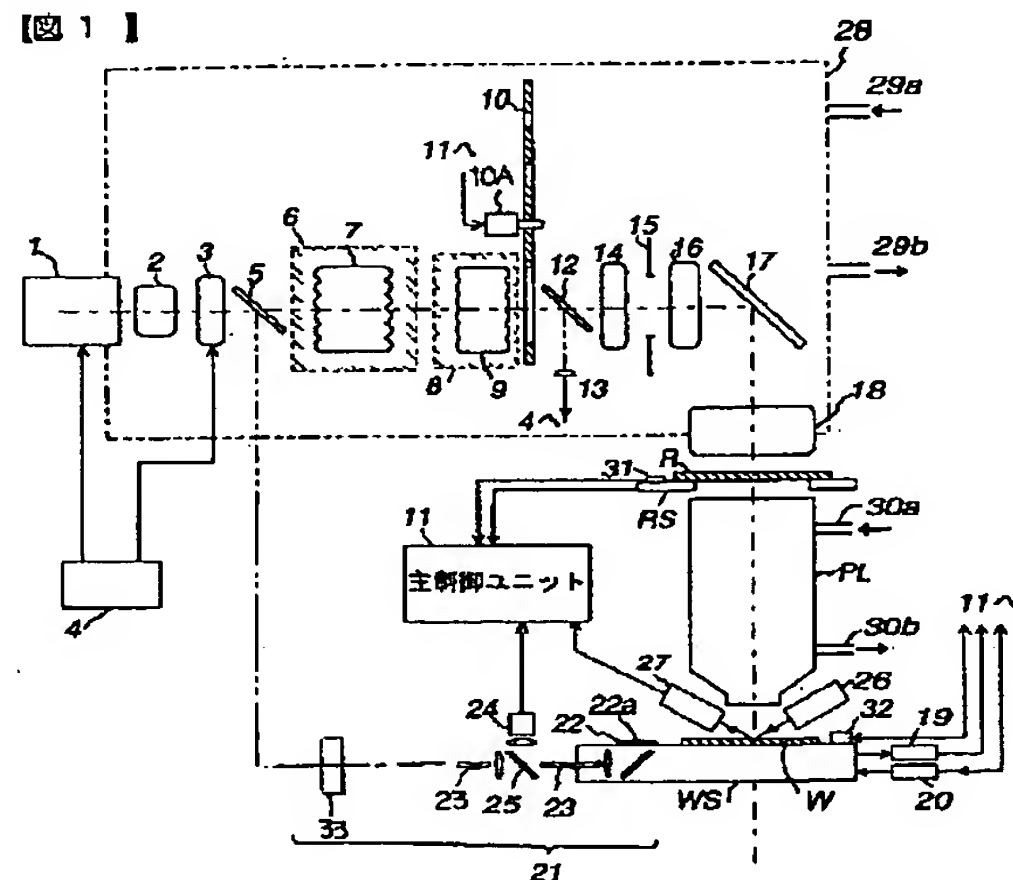
(54)【発明の名称】 光学素子光洗浄方法および投影露光装置

(57)【要約】

【課題】光学素子の感光基板側の面に付着する汚染物質を光洗浄する。

【解決手段】露光用レーザ光源1から出射されたレーザ光の分岐光は逆発光系21から投影光学系P Lに入射する。この逆発光光によって投影光学系P Lの複数の光学系のウェハ側の面が光洗浄される。

【図1】



## 【特許請求の範囲】

【請求項1】所定のパターンが形成された原版を露光光で照明し、照明された前記パターンの像を感光性基板に投影する光学素子を備えた投影露光装置の光学素子光洗浄方法において、前記露光光の進行方向と反対の方向から入射する洗浄光で前記光学素子を光洗浄することを特徴とする光学素子光洗浄方法。

【請求項2】請求項1の光洗浄方法において、前記洗浄光は前記露光光を分岐して生成した光であることを特徴とする光学素子光洗浄方法。

【請求項3】請求項1の光洗浄方法において、前記洗浄光は露光用光源とは別に設けられた洗浄用光源で生成するようにしたことを特徴とする光学素子光洗浄方法。

【請求項4】請求項1～3のいずれかに記載の光洗浄方法において、前記露光光の進行方向と反対の方向から入射する洗浄光で光学素子を光洗浄するのと並行して、前記露光光の進行方向から入射する露光光で光学素子を光洗浄することを特徴とする光学素子光洗浄方法。

【請求項5】請求項1～3のいずれかに記載の光洗浄方法において、前記光学素子の汚染状態を検出し、その汚染状態に応じて前記洗浄光で前記光学素子の表面を走査することを特徴とする光学素子光洗浄方法。

【請求項6】所定のパターンが形成された原版を露光光で照明し、照明された前記パターンの像を感光性基板に投影する光学素子を備えた投影露光装置において、前記露光光の進行方向と反対の方向から洗浄光を前記光学素子に射出する光洗浄光学系を備えることを特徴とする投影露光装置。

【請求項7】請求項6の露光装置において、前記露光用光源から射出されている照明光を前記光洗浄光学系へ前記洗浄光として導くための分岐光学素子を有することを特徴とする投影露光装置。

【請求項8】請求項6の露光装置において、前記洗浄光を生成するための前記露光用光源とは別の光洗浄用光源を備え、その光洗浄用光源からの光を前記光洗浄用光学系に導くようにしたことを特徴とする投影露光装置。

【請求項9】請求項6～8のいずれかに記載の投影露光装置において、前記光洗浄用光学系から射出される前記洗浄光で光学素子を光洗浄するのと並行して、照明光学系から露光方向に射出される前記露光光で前記光学素子を光洗浄することを特徴とする投影露光装置。

【請求項10】請求項6～8のいずれかに記載の投影露光装置において、前記光学素子の汚染状態を検出する汚染状態検出手段を備え、検出された汚染状態に応じて前記洗浄光学系を制御して前記洗浄光で前記光学素子の表面を走査することを特徴とする投影露光装置。

## 【発明の詳細な説明】

## 【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、例えば、LSI等

の半導体素子、CCD等の撮像素子、液晶表示素子、あるいは薄膜磁気ヘッド等の半導体素子を製造するための光リソグラフィー工程でマスクもしくはレチクル（以下、レチクルとする）等の原版のパターンをウエハ等の感光性基板に露光するための光学素子光洗浄方法および投影露光装置に関する。

## 【0002】

【従来の技術】半導体素子の高集積化に伴い、その半導体素子を製造するために重要な光リソグラフィー工程にて使用される投影露光装置も急速な進歩を遂げてきている。投影露光装置に搭載されている投影光学系の解像力は、Rayleighの式で良く知られているように、 $R = k \times \lambda / NA$ の関係で表される。ここで、 $R$ は投影光学系の解像力、 $\lambda$ は露光用の光の波長、 $NA$ は投影光学系の開口数、 $k$ はレジストの解像力の他にプロセスによって決定される定数である。

【0003】半導体素子の高集積化に対応して投影光学系での必要な解像力を実現するために、上式から分かるように、露光用の光源の短波長化や投影光学系の開口数を大きくする、いわゆる、高NA化への努力が続けられている。近年では、248nmの出力波長を持つ弗化クリプトンエキシマレーザ（KrFエキシマレーザ）を露光用光源として、投影光学系の開口数も0.6以上の露光装置が実用され、0.25μmにも達する微細なパターンの露光が可能となってきている。

【0004】特に、最近では、弗化クリプトンエキシマレーザに続く光源として、193nmの出力波長を持つ弗化アルゴンエキシマレーザ（ArFエキシマレーザ）が注目されてきている。この弗化アルゴンエキシマレーザを露光用光源とする露光装置が実現できれば、0.18μm～0.13μmまで及ぶ微細加工が可能となることが期待されており、精力的な研究開発が盛んに行われている。

【0005】この弗化アルゴンエキシマレーザの出力波長（193nm）の波長域では、透過率、加工性などの観点からレンズとして使用可能な材料は、現段階では合成石英ガラス、弗化カルシウム（蛍石）の2つに限定されているので、この種の露光装置用の光学材料として、十分な透過率と、内部均一性を有する材料の開発が引き続き精力的に行われている。合成石英ガラスでは内部透過率が0.995/cm以上、弗化カルシウムでは内部吸収が無視できるレベルにまで到達している。

【0006】光学材料の表面にコートされる反射防止膜用の材料も弗化クリプトンエキシマレーザの出力波長（248nm）の波長域のものと比べて選択範囲が非常に狭く、設計上の自由度に大きな制約を受ける。しかしながら、精力的な開発努力によりその問題も克服されつつあり、各レンズ面での損失が0.005以下というレベルまで実現されてきている。

## 【0007】



【発明が解決しようとする課題】このようなKrFエキシマレーザ光の波長よりも短い波長域においては、投影露光装置中の光学系（照明光学系、投影光学系）を構成する光学素子の表面に水分や有機物が付着して光学系の透過率が低下するという問題がある。これは、複数の光学素子に挟まれた空間内の気体、または光学系を支える鏡筒の内壁や接着剤等から発生する水分やハイドロカーボン、有機物が光学系の表面に付着すること起因する。

【0008】図5は光学系の透過率の時間変化特性を示すもので、レーザ光源からパルスレーザ光を連続して出射させながら、レーザ光源とレチクルとの間の露光光の照度とウェハ上の露光光の照度を所定期間間隔で計測し、その両照度の比である光学系透過率を計測時刻ごとに算出して表したものである。図5から分かるように、レーザ光の照射開始直後から徐々に透過率が上昇してある程度時間が経過するとほぼ飽和状態となる。このような透過率変動は、硝材の内部特性の変動や光学系表面に付着した水分や有機物がレーザの照射により光学系表面から取除かれるために起きる。

【0009】このため、投影露光装置における露光動作中、即ち照明光学系からの露光光でレチクルを照明するとともに、投影光学系によってそのレチクル上のデバイスパターンの少なくとも一部の像を感光性基板上に投影し、ステップアンドリビート方式、又はステップアンドスキャン方式でそのパターン像を順次感光性基板上に転写していくと、照明光学系や投影光学系の透過率が徐々に上昇する。ただし、この透過率の上昇は一時的な洗浄効果であり、露光光の照射により光学素子の表面が活性化された光学系は、その照射を停止すると、却って周囲の水分や有機物を付着し易くする。そこで、露光光の照射（露光動作）を長時間ないし長期に停止する場合は必要に応じて、露光開始前に露光用レーザ光を所定時間照射して光洗浄を行なうことにより透過率をほぼ飽和状態にし、しかる後に露光動作を開始することが考えられるが、所定の透過率まで洗浄するのに時間がかかる。また、露光光と同じ方向から洗浄光を入射すると、洗浄光の入射面に比べて出射面の光洗浄が不十分である。

【0010】本発明の目的は、光学素子の感光基板側の面を十分に光洗浄するようにした光学素子光洗浄方法および投影露光装置を提供することである。

【0011】

【課題を解決するための手段】実施の形態を示す図1～図4に対応づけて説明する。

(1) 請求項1の発明は、所定のパターンが形成された原版Rを露光光で照明し、照明されたパターンの像を感光性基板Wに投影する光学素子を備えた投影露光装置の光学素子光洗浄方法に適用される。そして、上述した目的は、露光光の進行方向と反対の方向から洗浄光を入射して光学素子を光洗浄することにより達成される。

(2) 請求項2の発明は、請求項1の光洗浄方法において、露光用光源1からの露光光を洗浄光として使用するものである。

(3) 請求項3の発明は、請求項1の光洗浄方法において、洗浄光を露光用光源1とは別に設けられた洗浄用光源51で生成するようにしたものである。

(4) 請求項4の発明は、請求項1～3のいずれかに記載の光洗浄方法において、露光光の進行方向と反対の方向から入射する洗浄光で光学素子を光洗浄するのと並行して、露光光の進行方向から入射する露光光で光学素子を光洗浄するようにしたものである。

(5) 請求項5の発明は、請求項1～3のいずれかに記載の光洗浄方法において、光学素子の汚染状態を検出し、その汚染状態に応じて洗浄光で光学素子の表面を走査するようにしたものである。

(6) 請求項6の発明は、所定のパターンが形成された原版Rを露光光で照明し、照明されたパターンの像を感光性基板Wに投影する光学素子を備えた投影露光装置に適用される。そして、露光光の進行方向と反対の方向から洗浄光を光学素子に射出する光洗浄光学系21を備えることにより、上述の目的は達成される。

(7) 請求項7の発明は、請求項6の露光装置において、露光用光源1から射出されている照明光を光洗浄光学系21へ洗浄光として導くための分岐光学素子5を有するものである。

(8) 請求項8の発明は、請求項6の露光装置において、洗浄光を生成するための露光用光源1とは別の光洗浄用光源51を備え、その光洗浄用光源51からの光を光洗浄光学系21に導くようにしたものである。

(9) 請求項9の発明は、請求項6～8のいずれかに記載の投影露光装置において、光洗浄光学系21から射出される洗浄光で光学素子を光洗浄するのと並行して、照明光学系から露光方向に射出される露光光で光学素子を光洗浄するものである。

(10) 請求項10の発明は、請求項6～8のいずれかに記載の投影露光装置において、光学素子の汚染状態を検出する汚染状態検出手段を備え、検出された汚染状態に応じて洗浄光学系21を制御して洗浄光で光学素子の表面を走査するものである。

【0012】以上の課題を解決するための手段の欄では実施の形態の図を参照して本発明を説明したが、これにより本発明が実施の形態に限定されるものではない。

【0013】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照しながら本発明による実施の形態について説明する。図1は本発明による投影露光装置の概略的構成を示している。図1に示すように、例えば193nmの出力波長を持つパルス光を発振するArFエキシマレーザ光源1からはほぼ平行光束としての出射されたレーザ光は、所定断面形状のレーザ光に整形するビーム整形光学系やビームエキスパンダな

どからなるビームマッチングユニット 2 を通過して可変減光器 3 に入射する。可変減光器 3 は、露光量制御ユニット 4 からの指令に応じてパルスレーザ光の減光率を段階的にもしくは無段階に調節する。減光器 3 の射出光はビームスプリッタ 5 に入射し、その透過光は照明光学ユニット 6 に入射する。なお、照明光学系はチャンバ 2 8 に收容され、レーザ光源 1 はチャンバ 2 8 の外に設置されるから、チャンバ 2 8 にはレーザ光源 1 からのレーザ光を通過させる透過窓（不図示）が設けられている。

【0014】また図 1 において、照明光学ユニット 6 には第 1 フライアイレンズ 7 が、照明光学ユニット 8 には第 2 フライアイレンズが設けられている。第 1 フライアイレンズ 7 の射出面近傍には 2 次光源としての面光源が形成される。第 1 フライアイレンズ 7 からの照明光は照明光学ユニット 8 に入射し、第 2 フライアイレンズ 9 の射出面近傍に 3 次光源としての面光源が形成される。

【0015】第 2 フライアイレンズ 9 によって形成される面光源の位置にはタレット板 1 0 が配設されている。石英等の透明基板からなるタレット板 1 0 には、 $\sigma$  値を変更する開口絞りや変形照明用開口絞りが設けられ、投影光学系 P L の解像力や焦点深度を向上させるためにい

ずれか一つが照明光路中の 3 次光源位置に挿入される。そのため、タレット板 1 0 はモータ 1 0 A で回転駆動され、レチクル R のパターンの種類に応じて 1 つの開口絞りが選択されて照明光学系の光路中に挿入される。モータ 1 0 A は主制御ユニット 1 1 からの指令で制御される。

【0016】第 2 フライアイレンズ 9 による 3 次光源からの光束は、可変開口絞りを通過してビームスプリッタ 1 2 で 2 つの光路に分岐され、反射光はインテグレート

センサ（光電検出器）1 3 に導かれて照明光の照度が検出される。検出された照度に応じた信号は露光量制御ユニット 4 に入力される。ビームスプリッタ 1 2 はその透過率は高いが、反射率は低く設定されている。一方、透過光は第 3 照明光学ユニット 1 4 により集光されて重畳的に照明視野絞りユニット（レチクルブラインド系）1 5 を照明する。この照明視野絞りユニット 1 5 は第 1 照明光学ユニット 6 中の第 1 フライアイレンズ 7 の入射面および第 2 照明光学ユニット 8 中の第 2 フライアイレン

ズ 9 の入射面と共役な位置に配置されている。ここで、照明視野絞りユニット 1 5 中のレチクルブラインドとレチクル R のパターン面とは、第 4 および第 5 照明光学ユニット 1 6, 1 8 に関してほぼ共役に配置されており、ブラインド開口によりレチクル R 上の照明領域が規定される。

【0018】そして投影光学系 P L によってウエハ W 上にレチクル R 上の回路パターンの像が形成され、ウエハ W 上に塗布されたレジストが感光して、ウエハ W 上に回路パターン像が転写される。

【0019】レチクル R はレチクルホルダを介してレチクルステージ R S に保持固定される。レチクルステージ R S は、図 1 の紙面と直交する面内に沿って 2 次元的に移動するように図示しないベースに設けられている。レチクルステージ R S にはミラーが設置され、レーザ干渉計からのレーザ光がミラーで反射されてレーザ干渉計に入射し、レーザ干渉計によりレチクルステージ R S の位置が計測される。この干渉計とミラーの図示は省略した。この位置情報は主制御ユニット 1 1 に入力され、この位置情報に基づいて主制御ユニット 1 1 はレチクルステージ駆動用モータを駆動してレチクル R の位置を制御している。また、レチクルステージ R S にはレチクル照度センサ 3 1 が設けられ、レチクル R に照射される照明光の照度が計測されて主制御ユニット 1 1 に入力される。

【0020】ウエハ W はウエハホルダを介してウエハステージ W S に保持固定される。ウエハステージ W S は、図 1 の紙面と直交する面内に沿って 2 次元的に移動するように設けられている。ウエハステージ W S にはミラー（図示を省略）が設置され、レーザ干渉計 1 9 からのレーザ光がミラーで反射されてレーザ干渉計 1 9 に入射し、レーザ干渉計 1 9 によりウエハステージ W S の位置が計測される。この位置情報は主制御ユニット 1 1 に入力され、この位置情報に基づいて主制御ユニット 1 1 はウエハステージ駆動系 2 0 を駆動してウエハ W の位置を制御している。ウエハステージ W S 上にはウエハ照度センサ 3 2 が設けられ、ウエハ W に照射される露光光の照度が検出される。このウエハ照度センサ 3 2 の検出信号は主制御ユニット 1 1 に入力される。レチクル照度センサ 3 1 の出力値をウエハ照度センサ 3 2 の出力値で除した値が投影光学系 P L の透過率となる。

【0021】次に、自動合焦系について図 2 も参照して説明する。自動合焦系は、ウエハステージ W S 上に設けられ、所定の開口パターン 2 2 a が形成されたフェデューシャルマーク 2 2 と、このフェデューシャルマーク 2 2 の開口パターン 2 2 a に露光光路から分岐された洗浄光を導く逆発光系 2 1 と、開口パターン 2 2 a を通過した洗浄光によりレチクルパターン面で形成されたパター



ン投影像の反射光を受光する光量検出器24と、投影光学系PLの下方に固定されてウェハW面の光軸方向の位置を検出する斜入射フォーカスセンサ26、27とを備える。光量検出器24と斜入射フォーカスセンサ27の検出信号は主制御系4に入力される。

【0022】逆発光系21は、露光光路から分岐された洗浄光を通過遮断するシャッタ33と、光ファイバケーブル23と、ハーフミラー25と、その他の光学系とを備え、ビームスプリッタ5から分岐された露光光は光ファイバケーブル23からハーフミラー25を介してフュ  
10 デューシャルマーク22の開口パターン22aに導かれる。なお、ArF光などの短波長光は光ファイバケーブルでの減衰が大きいため、光ファイバケーブル23に代えてミラーを組合せた光学系を用い、さらに光路を窒素  
ガスで置換するのが好ましい。

【0023】このような自動合焦系は次のようにして、ウェハステージの傾斜角度を調節するとともに、1ショットごとにウェハ表面にレチクルパターンを合焦させるようにする。ウェハを露光する前にシャッタ33を開いておく。これにより、露光用光源1からパルス光を射出  
20 させると、洗浄光がフュデューシャルマーク22に導かれ、開口パターン22aを通過する逆発光像は投影光学系PLを通してレチクルRに達し、レチクルパターン面に投影像が結像される。この投影像がレチクルパターン面で反射する光束は投影光学系PLを逆に進行してレチクルパターン面の投影光学系PLに関して共役な面に結像する。開口パターン22aの面が投影光学系PLに  
30 関してレチクルパターン面と共役な位置関係にあれば、レチクルパターン面での第1の投影像はピン트가あった境界が明瞭なものとなる。またこの場合、第1の投影像の反射光による第2の投影像は、開口パターン22aの面上で結像してピン트가あって境界が明瞭となる。第2の投影像は第1の投影像と同一形状、同一寸法、同一姿勢であるから、第2の投影像の光束の全てが開口パターン22aを通して光量検出器24に達し、受光量は最大となる。一方、開口パターン22aの面がレチクルパターン面の共役位置からずれている場合には、開口パターン22aの面上での第2の投影像はピン트가ずれて境界がボケたものとなる。その結果、第2の投影像は開口パ  
40 ターン22aからはみ出し、光量検出器24の受光量は低下する。

【0024】このような原理を用いて、ウェハステージWSの複数の位置におけるZ軸方向の高さ位置の情報を検出する。すなわち、開口パターン22aをレチクルパターン面上の複数の位置に順番に位置決めし、各位置において光量検出器24の出力が最大となるようにする。こうして得られた高さ情報に基づいてウェハステージWSの傾斜角度が図示しない傾斜角度調節機構によって調整される。傾斜が調整された後、開口パターン22aを投影光学系PLの光軸に移動させ、再度、開口パターン

22aの面が合焦位置となるようにウェハステージWSのZ軸高さ方向を調節する。そして、この状態で開口パターン22aの面を斜入射フォーカスセンサ26、27で検出し、この検出値、すなわち、フュデューシャルマーク22の面上でのビームスポット高さが原点として記憶される。その後ウェハステージWSの任意の位置に投影光学系PLの視野を走査した際には、斜入射フォーカスセンサ26、27における反射ビームスポットの高さにより試料の露光面高さが計測され、露光面高さが原点  
10 高さとなるように主制御ユニット11はウェハステージWSをZ軸方向に調節しながら露光が行なわれる。

【0025】自動合焦系のフュデューシャルマーク22から射出される逆発光はアライメント系としても使用される。図3はレチクルRとウェハステージWSの位置決めのアライメント系を説明する図である。レチクルRには黒パターンであるレチクルマークRMが形成されている。このレチクルマークRMは開口パターン22aの像をレチクルパターン面に投影した投影像と同一形状、同一寸法のパターンである。フュデューシャルマーク22  
20 の開口パターン22aを透過した逆発光光は投影光学系PLを通してレチクルRのパターン面に照射される。ウェハステージWSを移動させて開口パターン22aからの逆発光光の投影像を走査する。投影像がレチクルマークRMとちょうど重なり合うと、光量検出器34の受光量は最小となり光量信号も最小となる。このような手法によりレチクルRとウェハステージWSを位置合せできる。

【0026】また、光量検出器34に代えてCCDのような撮像素子で開口パターン22aの投影像とレチクルマークRMの位置関係を撮像し、この画像を画像処理してアライメントするようにしてもよい。

【0027】以上に構成される実施の形態の投影露光装置では、酸素による露光光の吸収を防ぐため、照明光学系を酸素の含有率を極めて小さく抑えた窒素ガスなどの不活性ガス雰囲気中に配設する。そのため、照明光学系のチャンバ28に不活性ガスを配管29aを介して供給する不活性ガス供給装置と、チャンバ28から汚染された不活性ガスを配管29bを介して排出する不活性ガス  
40 排出装置とが設けられる。また、投影光学系PLを構成する複数の光学部材間に形成される複数の空間にも窒素ガスなどの不活性ガスを供給し、汚染された不活性ガスを複数の空間から排出する。そのため、ガス供給装置は配管30aを介して投影光学系PLの内部へ乾燥した窒素などの不活性ガスを供給し、排出装置は投影光学系PLの内部の気体を配管30bを介して外部へ排出する。なお、不活性ガスとしては窒素に限ることなく、ヘリウム、アルゴン等の気体を用いることも可能である。

【0028】チャンバ28や投影光学系PLの鏡筒の気密性が高い場合には、いったん大気と窒素を完全に置換した後は、その置換を頻繁に行なう必要はない。しかし

ながら、光路内に介在する硝材、コート材、接着剤、塗料、金属、セラミックなどの各種の物質から発生する水分子や hidrocarbon などが光学素子の表面に付着して透過率変動が起こるので、常時窒素ガスをチャンバ内や投影光学系の鏡筒内に流しつつ、ケミカルフィルタや静電フィルタによってチャンバ内や投影光学系の鏡筒内の不純物を除去するのが好ましい。

【0029】次に本例における動作について説明する。まず、図1に示すように、乾燥した窒素等の不活性ガスをガス供給装置から配管29a、30aを介してチャンバ28と投影光学系PLの鏡筒内部に供給し、完全に充填された後、排出装置によりチャンバ28と投影光学系PLの鏡筒内部の気体を配管29a、30bを介して外部へ排出する。

【0030】なお、上述したように、露光中もガス供給装置と排出装置を常時作動させ、チャンバ28や投影光学系PLの鏡筒内の光学素子間の雰囲気等を常に乾燥清浄された状態に保持するのが好ましいが、露光動作に先立ってチャンバ28や投影光学系PLの鏡筒のレンズ室などの光学素子間に形成される空間の気体を清浄化した後は、供給装置と排出装置を停止させてもよい。

【0031】次いで、不図示のレチクルローディング機構により、転写対象となるパターンが描画されたレチクルRをレチクルステージRSの上に搬送して載置する。このとき、そのレチクルRが所定の位置に設置されるように、不図示のレチクルアライメント系によりそのレチクルRの位置を計測し、その結果にしたがって、不図示のレチクル位置制御回路によってレチクルRの位置を所定の位置に設定する。

【0032】レチクルRのパターンが転写されるウェハWの表面には感光材料であるレジストがあらかじめ塗布されており、その状態で不図示のウェハローディング機構によりウェハWが搬送されてウェハステージWS上に設置される。ウェハWはウェハステージWS上でアライメントされて保持固定される。

【0033】露光作業を開始する前に、ウェハステージWS上に設けた照度センサ32を投影光学系PLの光軸上に移動して、インテグレータセンサ13の計測値L1と照度センサ32の計測値LWをサンプリングする。一方、レジスト材の感度特性などに応じてウェハ上での目標照度TLが設定される。インテグレータセンサ13は第1および第2フライアイレンズ7、9で均一化された露光光の照度に応じた検出信号LIを出力する。照度センサ32はウェハステージWS上の露光光の照度に応じた検出信号LWを出力する。インテグレータセンサ13の検出信号LIと照度センサWSの検出信号LWとの比（センサ32の出力LW／センサ13の出力LI）を算出し、この比LW／LIに所定の係数K1を乗じてゲイン $\alpha$ を演算する。そして露光作業中は、インテグレータセンサ13の出力信号にゲイン $\alpha$ が乗じられて推定実照

度LPRが出力される。すなわち、推定実照度LPRは、露光開始時においてインテグレータセンサ13の計測値が100でウェハ上の照度が50であるとした場合、50／100の比率に所定の係数K1を乗じて求めたゲイン $\alpha$ と、露光中のインテグレータセンサ13の出力信号とを乗じてウェハ上の照度を推定したものである。そして、推定実照度LPRが照度目標値TLになるように、主制御ユニット11からの指令にしたがって露光量制御ユニット4が光源1への印加電圧（充電電圧）を変更することで、レーザ光源1の出力が調節される。また、露光量制御ユニット4が減光器3の透過率（減光率）を調整してもよいし、あるいは光源1と減光器3の両方を制御してもよい。これにより、光源の劣化に伴う照度の低減が防止される。

【0034】ウェハステージWS上に設置されたウェハWは第1回目のパターンの転写では、そのウェハW上にパターンは存在せず、ウェハステージWS上の所定の位置に、例えばウェハWの外径基準で定められる位置に設置される。その後、ウェハW上にパターンが転写される。この転写は、レチクルR上のパターンの一部を可変視野絞り（レチクルブラインド）15によって選択的に照明し、レチクルステージRSによってレチクルRをその可変視野絞り15によって規定される照明領域に対して相対移動し、それに同期しながらウェハWをウェハステージWSによって投影光学系PLに関してその照明領域と共役な投影領域に対して相対移動する、いわゆる走査型の転写（ステップアンドスキャン方式）である。あるいは、転写したいレチクルR上のパターン領域の全面を1度に全て照明して転写するステップアンドリピート方式でもよい。

【0035】ウェハWに対する第2回目以降のパターンの転写の場合には、少なくともウェハW上にはパターンが存在するから、そのあらかじめ転写されたパターンに付設されるマークを不図示のウェハアライメント系により計測することによりウェハW上のそのパターンの位置を計測し、その結果にしたがって、ウェハW上に先に転写されたパターンに対して、これから転写するパターンが所定の位置関係になるように、レチクルステージRSやウェハステージWSの位置を制御する。

【0036】このようなパターン露光中、露光光により投影光学系PLは光洗浄されるが、露光開始前は汚染物質が光学系の表面に付着していて透過率が低い値にあり、また、露光光の照射を停止すると雰囲気中に浮遊している汚染物質が光学系の表面に再付着して透過率が低下する。そのため、露光開始前にいわゆるパルス空打ちにより光洗浄を行ない、光学系表面から汚染物質を除去して透過率を所定値以上に高めてから露光を開始する。また、この実施の形態では露光開始前に自動合焦系によりウェハステージWSの傾斜角度を調整するが、このとき、逆発光系21から照射されるパルス光により投



影光学系P Lは光洗浄される。この場合、パルス光は露光光とは逆方向にウエハステージW S側から進行するので、露光光により光洗浄される面とは逆の面にパルス光が照射される。したがって、レチクル側からの露光光では除去しきれない投影光学系P Lのウエハ側の面に付着する汚染物質を除去することができる。

【0037】ここで、露光前のパルス空打ちと並行して逆発光系21からも洗浄光を照射しながらウエハステージW Sを走査すれば、投影光学系P Lのウエハステージ側の面に照射される逆発光系21からの光でも光洗浄されるので、光洗浄時間が短縮できる。また、逆発光系21からの洗浄光を使用するので開口絞りの大きさや形状に影響を受けることなく、所定の光洗浄を行なうことができる。

【0038】露光中や露光停止中に投影光学系P Lの透過率を演算し、その透過率が所定値以下に低下したときに光洗浄を行なうようにしてもよい。演算結果の透過率が所定値以下の場合には、シャッタ33を開き、ウエハステージW Sを移動してフュデューシャルマーク22を投影光学系P Lの照射領域内で走査しながら、レーザ光源1からレーザ光を照射する。したがって、投影光学系P Lが露光光と逆発光系からの光の双方で光洗浄され、露光光だけで光洗浄する場合に比べて光洗浄効率がよい。

【0039】投影光学系P Lの汚染ムラを測定し、汚染が進んでいる領域を逆発光で狙い打ちして光洗浄することができる。すなわち、ウエハステージW S上の照度センサ32を投影光学系P Lの照明領域内で走査することにより、主制御ユニット11において、投影光学系P Lの汚染状態を検出する。そして、汚染状態が悪い領域に逆発光系21からの照射光が照射されるようにウエハステージW Sを移動させることにより、特定の箇所のみ光洗浄を行なって汚染ムラを解消できる。

【0040】逆発光系21からの光で投影光学系P Lを洗浄する場合、レチクルステージR S上にミラーを設置し、逆発光系21から照射される光をそのミラーで全反射させることにより光洗浄効率を高めることができる。

【0041】以上では、露光用レーザ光源1の射出光を洗浄用光学系に分岐して洗浄光を生成したが、露光光量が不足する場合には、洗浄用光源を用いるのが好ましい。図4はその場合の投影露光装置の一実施の形態を示す。図4に示すように、洗浄用光源51からの出射光はシャッタ33を介して光ファイバケーブル23に入射される。洗浄用光源51は露光用レーザ光源1と同一のものでよいが、光洗浄効果が期待できればその他の光源でもよく、たとえば、低圧水銀灯を使用できる。

【0042】さらに以上では自動合焦系やアライメント系に使用する逆発光光を用いるようにしたが、この逆発光系とは別にウエハステージW S側から洗浄光を照射する光洗浄専用の光学系を用いてもよい。この場合、照明

領域を大きくすることができ、開口パターン22aの走査時間よりも短い時間で洗浄できる。また、図1あるいは図2に示した逆発光系のNAは小さく、洗浄領域も極めて限られ、洗浄できない領域が残ってしまう。そこで、NAを大きくしたり、凹レンズなどにより光束を広げるレンズを用いてもよい。あるいは、微細な回折格子を介して洗浄光を投影光学系P Lに入射させて、洗浄領域を広げてもよい。

【0043】以上の実施の形態と請求項との対応において、レチクルRが原版を、逆発光系21が洗浄用光学系を、主制御ユニット11が汚染状態検出手段をそれぞれ構成する。

【0044】

【発明の効果】(1) 以上のように本発明によれば、露光光の進行方向と反対の方向から入射する洗浄光で光学素子を光洗浄するようにしたので、露光光では洗浄し切れない感光基板側の汚れを洗浄することができる。

(2) 洗浄光を露光光を分岐して生成すれば、専用の光源が不要となる、低コスト化を図ることができる。

(3) 洗浄光を露光用光源とは別に設けた洗浄用光源で生成することにより、露光光の光量を落とすことなく大きな光量で洗浄することができる。

(4) 露光光の進行方向と反対の方向から入射する洗浄光で光学素子を光洗浄するのと並行して、露光光の進行方向から入射する露光光で光学素子を光洗浄することにより、短時間で所定の透過率まで洗浄することができ、スループットが向上する。

(5) 光学素子の汚染状態を検出し、その汚染状態に応じて洗浄光を走査すれば、局所的な汚染状態を除去することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明による投影露光装置の一実施の形態の概略的構成を示す図

【図2】図1の自動合焦系の詳細図

【図3】図2の自動合焦系の逆発光光を用いるアライメント系を説明する図

【図4】洗浄用に専用の光源を用いた実施の形態を示す図

【図5】透過率変動を説明する図

【符号の説明】

- 1 ArFエキシマレーザ光源
- 4 露光量制御ユニット
- 11 主制御ユニット
- 13 インテグレートセンサ
- 21 逆発光系
- 24 光量検出器
- 31 レチクル照度センサ
- 32 ウエハ照度センサ
- 33 シャッタ
- 51 洗浄用光源

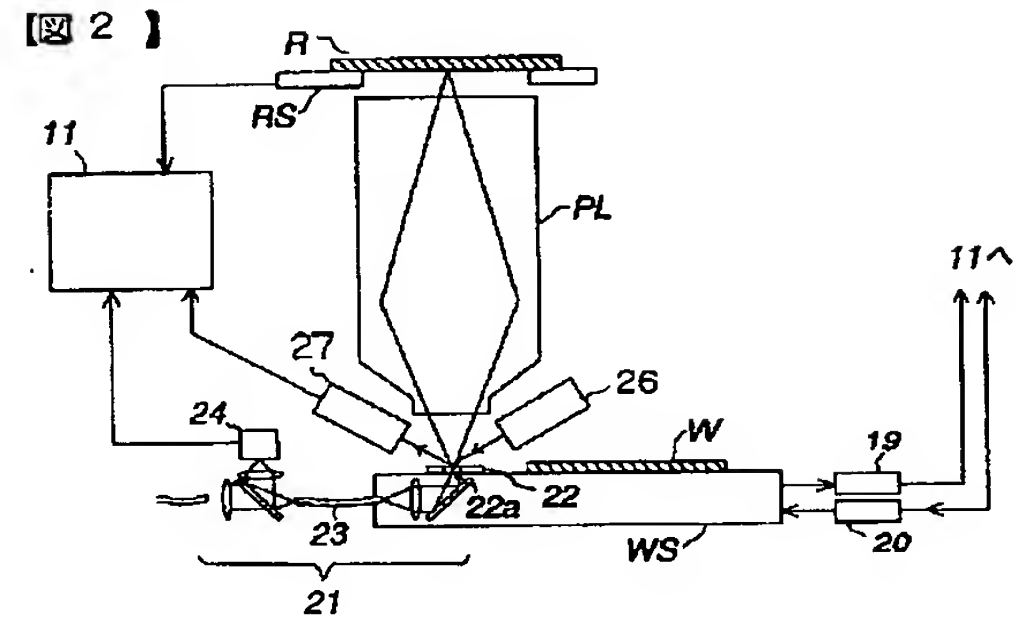
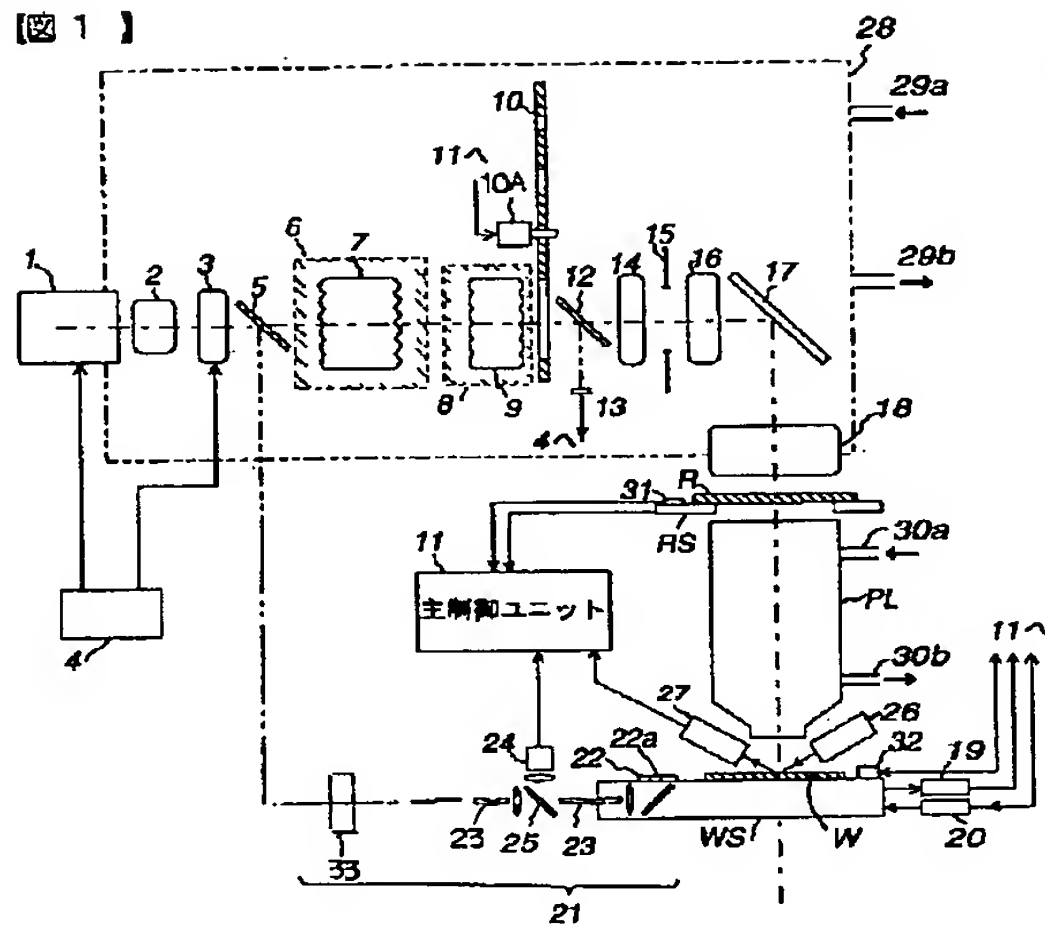
R レチクル  
RS レチクルステージ  
PL 投影光学系

\* W ウエハ  
WS ウエハステージ

\*

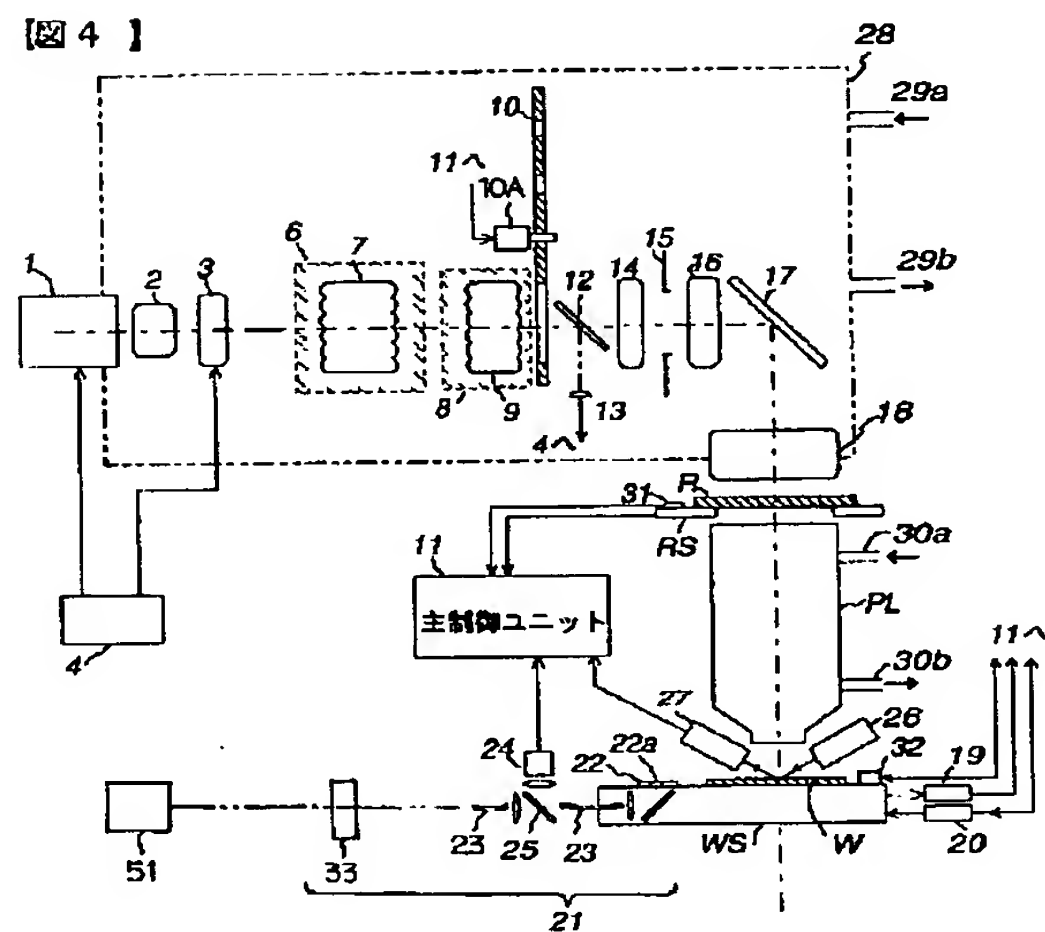
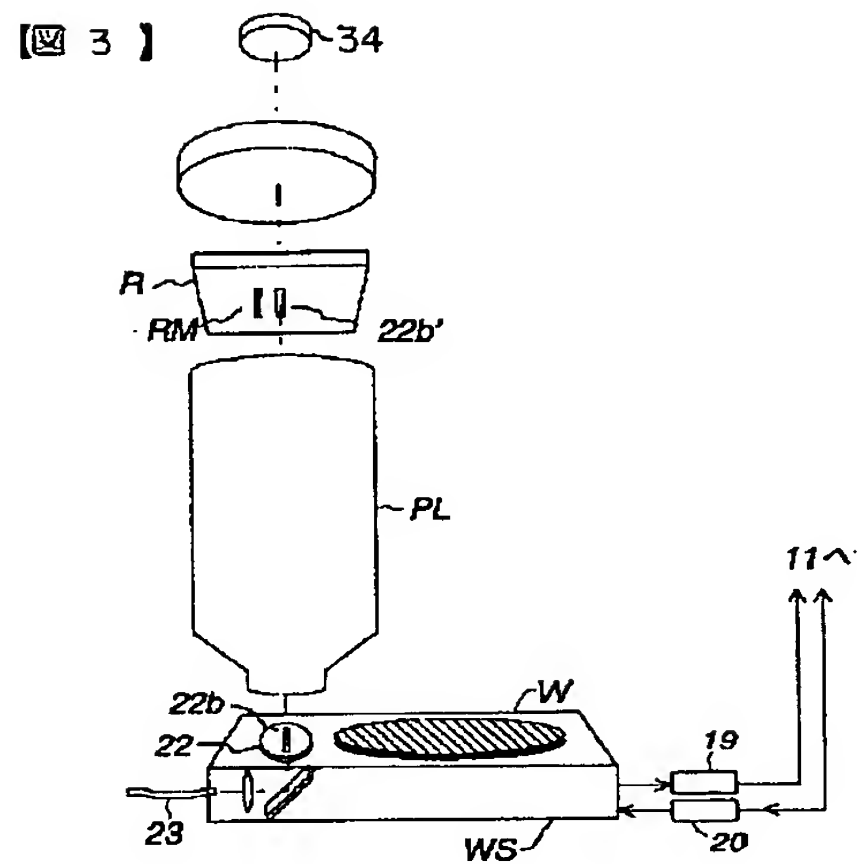
【図1】

【図2】



【図3】

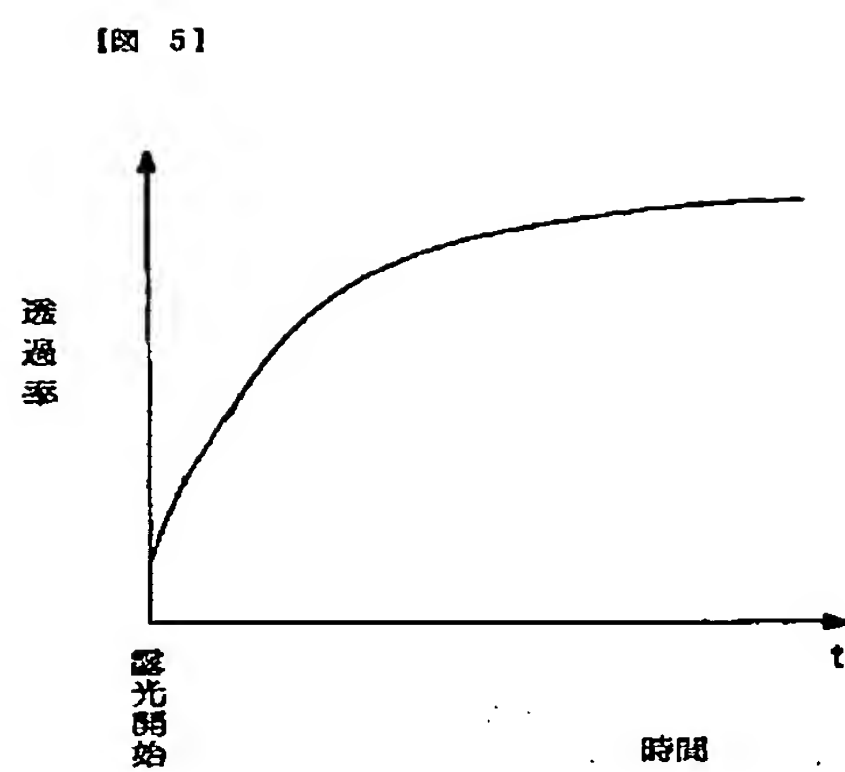
【図4】



(9)

特開平11-233402

【図5】





**THIS PAGE BLANK (USPTO)**